

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 4 区分

【発行日】平成 24 年 2 月 9 日 (2012.2.9)

【公表番号】特表 2011-507472 (P2011-507472A)

【公表日】平成 23 年 3 月 3 日 (2011.3.3)

【年通号数】公開・登録公報 2011-009

【出願番号】特願 2010-538224 (P2010-538224)

【国際特許分類】

H 0 2 K 15/02 (2006.01)

【F I】

H 0 2 K 15/02 F

H 0 2 K 15/02 E

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 12 月 13 日 (2011.12.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

三次元積層形状を構成するための方法であって、
 スプールに組み付けられる異なる幅を有する複数の積層ストリップから第 1 の積層ストリップを選択するステップと、
 前記第 1 の積層ストリップを積層デバイス上に積層するステップと、
 前記第 1 の積層ストリップを第 1 の積層長さにカットするステップと、
 第 2 の積層ストリップを前記スプールから選択するステップと、
 前記第 2 の積層ストリップを前記積層デバイス上に積層するステップと、
 第 1 の積層長さと異なる第 2 の積層長さで前記第 2 の積層ストリップをカットして、電気力学的デバイスの界磁極のための三次元積層形状を構成するステップと、
 を備える、方法。

【請求項 2】

前記第 1 の積層ストリップおよび前記第 2 の積層ストリップがパンチ加工された積層特徴部を含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記第 1 の積層ストリップおよび前記第 2 の積層ストリップが空隙面プロファイルを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

前記第 1 の積層ストリップおよび前記第 2 の積層ストリップが、積層幅パラメータ、積層長さパラメータ、積層空隙面パラメータ、積層体積層高さパラメータ、および、積層溶接パターンパラメータのうちの少なくとも 1 つから選択される積層パラメータにしたがって処理される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】

前記第 1 の積層ストリップを前記第 2 の積層ストリップにレーザ溶接するステップを更に備える、請求項 1 に記載の方法。